



 长沙黄花国际机场	----- 打车15分钟	} 浏阳泰科天润半导体技术有限公司	 北京首都国际机场	----- 打车30分钟	} 泰科天润半导体科技(北京)有限公司
 长沙高铁南站	----- 打车50分钟		 北京西站	----- 打车90分钟	
 长沙火车站	----- 打车50分钟		 北京南站	----- 打车90分钟	

SiC芯片/功率器件

SiC POWER DEVICES

**泰科天润 >>2025**



公众号

地址:北京市顺义区文良街15号1号楼2层东侧  
 地址:湖南省浏阳高新技术产业开发区永和南路金阳新能源产业园18号  
 市场需求请联系:0731-81810988转8015  
 邮箱:market@gpt.cn  
 网址:http://www.gpt.cn/



# 泰科天润

## 碳化硅 6 英寸晶圆生产线

# CONTENTS

## >> 目录



### P03 公司简介

- 关于我们-----03
- 资质荣誉-----04
- 发展历程-----05/06
- 6寸线概要-----07/08

### P09 产品

- 碳化硅器件的优势-----09
- 碳化硅器件的封装-----10
- 碳化硅MOSFET选型表-----11
- 碳化硅混合单管产品-----12
- 碳化硅二极管选型表-----13/20
- 应用领域-----21

### P22 联系我们

- 联系我们-----22

# 关于我们/About us

泰科天润半导体科技(北京)有限公司成立于2011年,是中国碳化硅功率器件产业化领军企业,专业从事碳化硅器件研发与制造,并提供应用解决方案。总部坐落于北京,是一家IDM企业,拥有两条碳化硅芯片晶圆生产线。公司有13年碳化硅器件量产经验,涵盖研发、制造、工艺、品控、应用方案和销售六个方向。

同时,公司建有可靠性实验室、器件评估实验室、失效分析实验室、系统应用实验室,为向客户提供优质产品提供有力保障。泰科天润的碳化硅产品范围覆盖650V-3300V(0.5A-100A)等多种规格,已经批量应用于PC电源、光伏逆变器、充电模块、OBC、DC-DC等多个领域,并屡次获得行业优秀产品奖。

公司质量资质有:ISO9001/IATF16949/RoHS/REACH/UL/DNV·GL/USCG/AEC-Q101等。



# 资质荣誉 / Certifications



车规认证: IATF16949



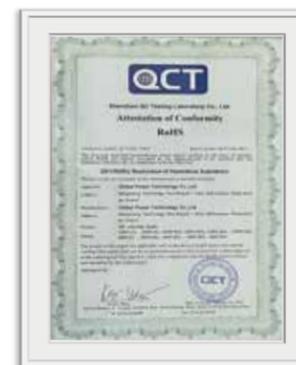
车规认证: AEC-Q101



质量认证: ISO9001



欧盟认证: REACH



欧盟认证: RoHS



职业健康安全管理体系认证: ISO45001



环境管理体系认证: ISO4001



131项专利认证及检测报告



客户荣誉



国家级高新技术企业

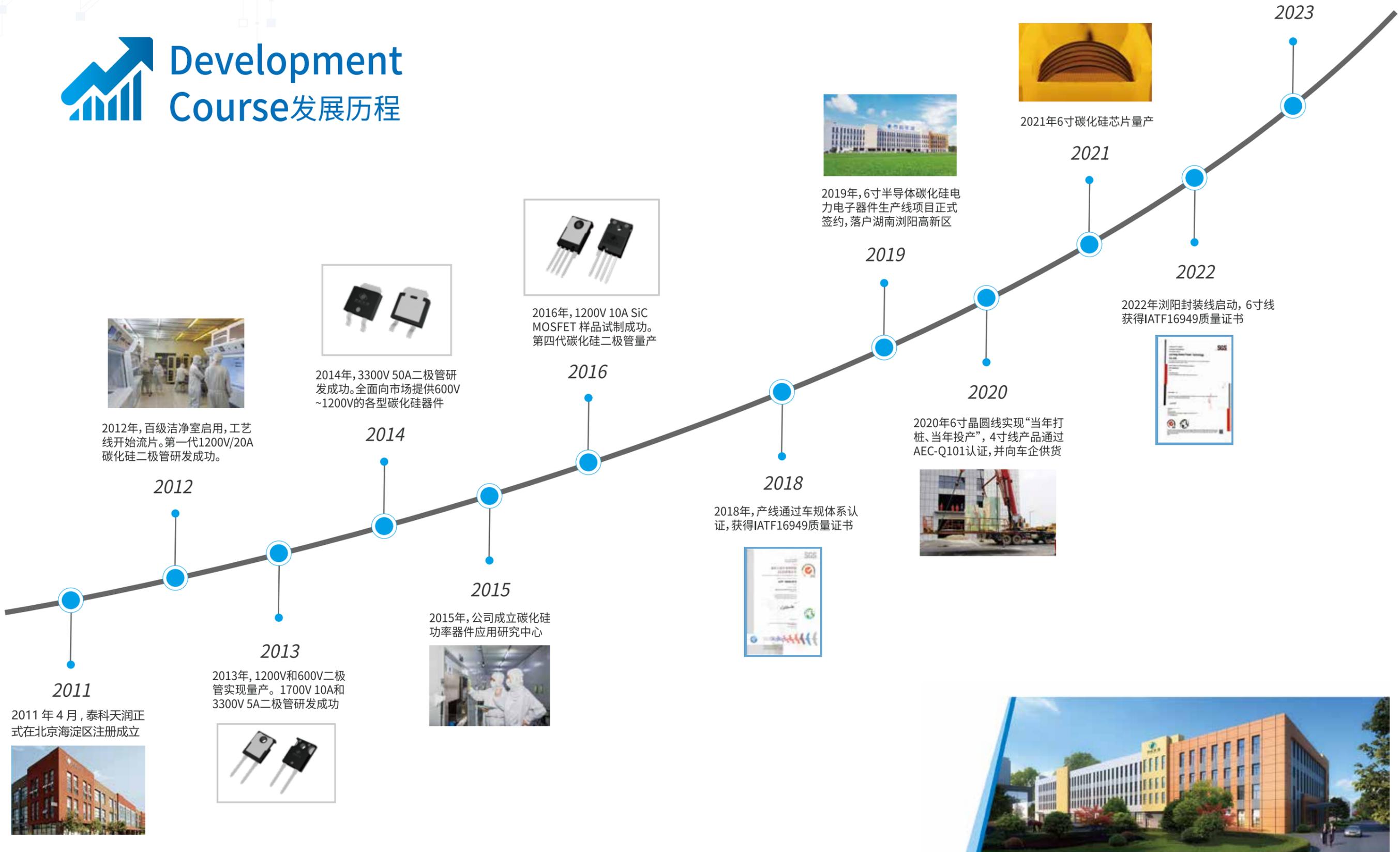


中关村高新技术企业



中国芯集成电路产业促进会  
“优秀市场表现产品”

# Development Course 发展历程



## >>> 碳化硅 6 英寸晶圆生产线

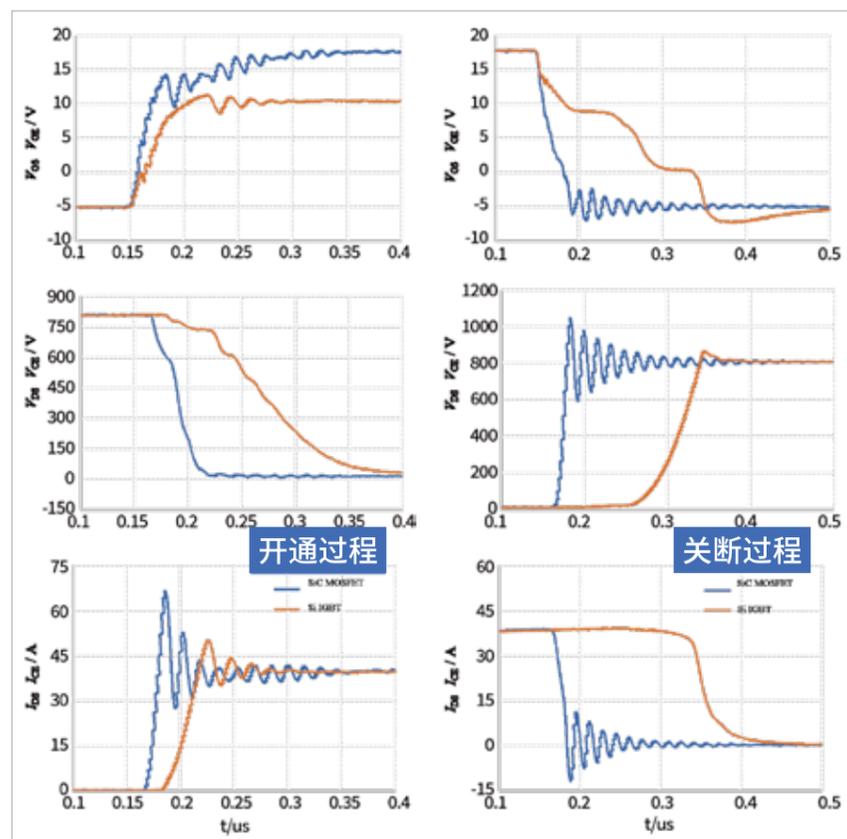
泰科天润6寸碳化硅晶圆产业园坐落于湖南省浏阳高新区,是湖南省重点引进落地项目。产线拥有碳化硅功率器件专用生产高端设备,包括高温离子注入机、高温退火炉、高温氧化炉、碳薄膜溅射台等,掌握全面的器件研发、工艺开发、生产制造能力。在泰科天润全体员工共同努力下,实现了“当年打桩、当年投产”的泰科速度。泰科天润6寸碳化硅晶圆线现已向市场批量供货,实现了国产碳化硅功率半导体的自主控制,突破了行业领域技术壁垒,填补了国内产业空白。



# 碳化硅器件的优势

Advantages of Silicon Carbide Devices

第三代半导体器件—碳化硅功率器件,拥有低导通电阻,高开关速度,高工作温度等优异特性,可广泛应用于功率控制和功率管理领域。与传统硅功率器件相比,使用碳化硅功率器件能提高系统效率,大幅减少系统体积,提高功率密度,是适应功率设备未来发展的最好选择。



SiC MOSFET开关速度远高于IGBT  
dv/dt高达100V/ns, di/dt高达 5A/ns

	SiC MOSFET	IGBT	倍数
开通延时	11.7ns	181.2ns	15.5
电压下降时间	48.2ns	186.9ns	3.9
电流上升时间	12.2ns	34.2ns	2.8
开通能量	652uJ	2623uJ	4.0
关断延时	17.2ns	21.31ns	1.2
电压上升时间	13.6ns	76.8ns	5.7
电流下降时间	14.7ns	111.4ns	7.6
关断能量	121uJ	1621uJ	13.4

泰科天润的SiC器件产品覆盖650V/1200V/1700V/2000V/3300V (0.5A-100A)

封装:提供TO220、TO220全包封、TO220内绝缘、TO247-2L、TO247-3L、TO247-4L、TO-252、TO263、TO263-7、DFN5×6、DFN8×8、SOD123、SMA等多款塑封以及高温封装形式,并可按客户需求提供其他封装形式。

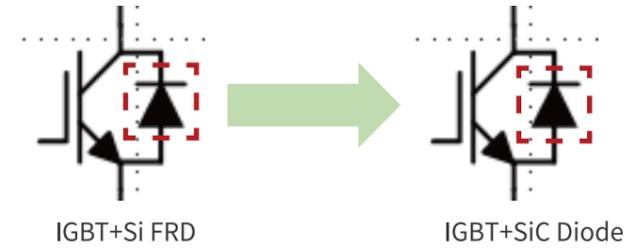
## 封装样式查询表:



## 碳化硅MOSFET选型表

产品料号 ID	封装 Package	V <sub>DS</sub>	I <sub>D</sub>		R <sub>DS(ON)</sub>	
			TC=25°C	TC=100°C	T <sub>j</sub> =25°C	
					Typ	Max
G2M016120N	TO-247-4L	1200V	150.6A	107.8A	15.5	20
G2M030120N	TO-247-4L	1200V	110.4A	80.6A	26	45
G2M040120N	TO-247-4L	1200V	87.5A	64.2A	39	60
G2M040120B	TO-247-3L	1200V	87.5A	64.2A	39	60
G2M040120D7S	TO-263-7L	1200V	87.5A	64.2A	39	60
G2M060120N	TO-247-4L	1200V	69A	50.1A	59	70
G1M080120N	TO-247-4L	1200V	55.5A	41.4A	80	100
G1M080120B	TO-247-3L	1200V	55.5A	41.4A	80	100
G2M080120D7	TO-263-7L	1200V	56.8A	42.3A	80	100
G2M080120N	TO-247-4L	1200V	release soon			
G1M012200N	TO-247-4L	2000V	release soon			
G1M024200N	TO-247-4L	2000V	release soon			
G1M050200N	TO-247-4L	2000V	release soon			
G1M075200N	TO-247-4L	2000V	release soon			
G1M100200N	TO-247-4L	2000V	release soon			

## 碳化硅混合单管



### 器件层面:

- ✓ 几乎可以忽略不计的反向恢复
- ✓ 有效降低桥式电路应用中IGBT的开通损耗

### 系统层面:

- ✓ 提高效率, 降低温升, 改善IGBT温升过高问题
- ✓ 开关频率从传统的最高50kHz提升到100kHz
- ✓ 提供功率密度, 降低系统成本
- ✓ 相较于SiC MOSFET成本更优, 可靠性更高

### 应用拓扑:

- ✓ 图腾柱无桥PFC
- ✓ 400V平台DC-DC、桥式逆变
- ✓ 800V平台I型三电平逆变

### 应用领域:

- ✓ UPS
- ✓ 电机驱动
- ✓ 光伏逆变、大功率电源

超巧致精系列  
SUPERSMART

## 碳化硅2in1半桥模块

GPT040M0120HBMX1

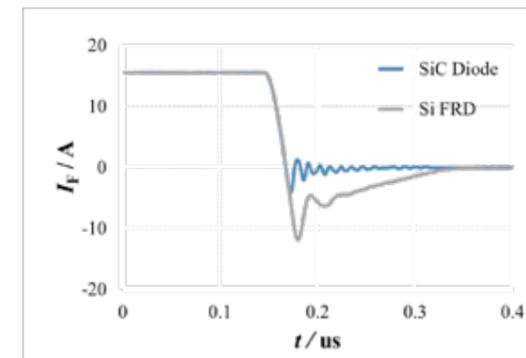
• 低成本碳化硅模块解决方案 •

✓ 易用 ✓ 快捷 ✓ 高效

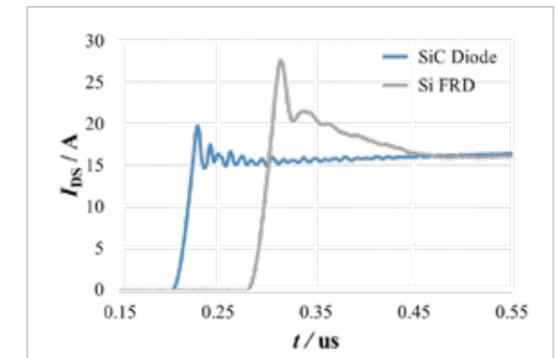
模块优势

- 高电压耐受力
- 提高功率密度
- 快速开关速度
- NTC温度监控
- 简化研发设计
- 内部绝缘设计

拓扑图



二极管反向恢复电流波形



对管开通电流波形

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流		正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tc=160°C	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max	
G51XT	SOD123	650	1(156°C)	1.4	1.6	
G51YT	SMA	650	1(157°C)	1.4	1.6	
G52YT	SMA	650	2(140°C)	1.3	1.7	
G53YT	SMA	650	3(164°C)	1.31	1.6	
G21XT	SOD123	1200	1(153°C)	1.35	1.7	
G22YT	SMA	1200	2(153.5°C)	1.3	1.7	
G3S06004J	TO-220ISO	600	4(143°C)	1.53	1.7	
G3S06006J	TO-220ISO	600	6(149°C)	1.36	1.7	
G3S06008J	TO-220ISO	600	8(144.5°C)	1.38	1.7	
G3S06010J	TO-220ISO	600	10(146°C)	1.39	1.7	
G3S06502A	TO-220AC	650	2(161.5°C)	1.53	1.7	
G3S06502C	TO-252	650	2(155.5°C)	1.53	1.7	
G3S06502H	TO-220F	650	2(158°C)	1.37	1.7	
G3S06502R	TO-252左脚悬空	650	2(156.5°C)	1.53	1.7	
G3S06504A	TO-220AC	650	4(150°C)	1.53	1.7	
G3S06504C	TO-252	650	4(149°C)	1.53	1.7	
G3S06504H	TO-220F	650	4(142°C)	1.53	1.7	
G3S06504J	TO-220ISO	650	4(149°C)	1.53	1.7	
G3S06504G	TO-220ABISO	650	4(144°C)	1.53	1.7	
G3S06504R	TO-252左脚悬空	650	4(152°C)	1.53	1.7	
G3S06506A	TO-220AC	650	6(158.5°C)	1.36	1.7	
G3S06506C	TO-252	650	6(156.5°C)	1.36	1.7	
G3S06506D	TO-263	650	6(159°C)	1.36	1.7	
G3S06506H	TO-220F	650	6(145°C)	1.36	1.7	
G3S06506R	TO-252左脚悬空	650	6(157°C)	1.43	1.7	

Note: If for 7000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流		正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tc=160°C	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max	
G3S06506U	TO-263左脚悬空	650	6(161°C)	1.43	1.7	
G3S06508A	TO-220AC	650	8(156.5°C)	1.38	1.7	
G3S06508C	TO-252	650	8(153.5°C)	1.38	1.7	
G3S06508D	TO-263	650	8(156°C)	1.38	1.7	
G3S06508H	TO-220F	650	8(134°C)	1.38	1.7	
G3S06508J	TO-220ISO	650	8(146°C)	1.38	1.7	
G3S06508R	TO-252左脚悬空	650	8(161.5°C)	1.38	1.7	
G3S06510A	TO-220AC	650	10(153.5°C)	1.39	1.7	
G3S06510C	TO-252	650	10(154°C)	1.39	1.7	
G3S06510D	TO-263	650	10(154°C)	1.39	1.7	
G3S06510H	TO-220F	650	10(125°C)	1.39	1.7	
G3S06510M	TO-220F	650	10(133.5°C)	1.39	1.7	
G3S06510P	TO-247AC-2L	650	10(152°C)	1.39	1.7	
G3S06510R	TO-252左脚悬空	650	10(155°C)	1.43	1.7	
G3S06510G	TO-220AB ISO	650	10(140°C)	1.39	1.7	
G3S06520A	TO-220AC	650	20(140°C)	1.52	1.7	
G3S06520D	TO-263	650	20(148.5°C)	1.5	1.7	
G3S06520H	TO-220F	650	12.6(125°C)	1.52	1.7	
G3S06520P	TO-247AC-2L	650	20(144°C)	1.5	1.7	
GAS06520A	TO-220AC	650	20(148.5°C)	1.38	1.7	
GAS06520D	TO-263	650	20(153.5°C)	1.38	1.7	
GAS06520P	TO-247AC-2L	650	20(150.5°C)	1.38	1.7	
G3S06520W	TO-3PF	650	20(133°C)	1.5	1.7	
G3S06520WW	TO-3PF	650	10*( 147.5°C)	1.39	1.7	
G3S06520U	TO-263	650	20(152.5°C)	1.5	1.7	

Note: If for 7000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流	正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max
GAS06520U	TO-263	650	20(157.5°C)	1.38	1.7
G3S06530A	TO-220AC	650	30(143°C)	1.41	1.7
G3S06530D	TO-263	650	30(154.5°C)	1.41	1.7
G3S06530L	TO-247AB-3L	650	30(152°C)	1.44	1.7
G3S06530PM	TO-247AC-2L	650	30(144.5°C)	1.41	1.7
G3S06550A	TO-220AC	650	50(147°C)	1.47	1.7
G3S06550PM	TO-247AC-2L	650	50(143.5°C)	1.47	1.7
G3S065100P	TO-247AC-2L	650	100(135°C)	1.65	2
G3S06510B	TO-247AB-3L	650	5*(162.5°C)	1.3	1.7
G3S06512B	TO-247AB-3L	650	6*(159°C)	1.36	1.7
G3S06516B	TO-247AB-3L	650	8*(154°C)	1.35	1.7
G3S06520B	TO-247AB-3L	650	10*(153.5°C)	1.39	1.7
G3S06540B	TO-247AB-3L	650	20*(144°C)	1.5	1.7
G3S06540WW	TO-3PF	650	20*(126°C)	1.5	1.7
G3S06560B	TO-247AB-3L	650	30*(151°C)	1.41	1.7
G3S06560WW	TO-3PF	650	30*(135.5°C)	1.41	1.7
GAS06540B	TO-247AB-3L	650	20*(155°C)	1.38	1.7
G4S06010JT	TO-220ISO	600	10(136.5°C)	1.37	1.7
G4S06506AT	TO-220AC	650	6(133.5°C)	1.68	1.8
G4S06506HT	TO-220F	650	5(125°C)	1.68	1.8
G4S06506CT	TO-252	650	6(133.5°C)	1.68	1.8
G4S06506DT	TO-263	650	6(129.5°C)	1.68	1.8
G4S06508AT	TO-220AC	650	8(153.5°C)	1.42	1.7
G4S06508CT	TO-252	650	8(153°C)	1.4	1.7
G4S06508DT	TO-263	650	8(152°C)	1.42	1.7

Note: If for 7000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流	正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max
G4S06508HT	TO-220F	650	8(140°C)	1.4	1.7
G4S06508JT	TO-220ISO	650	8(145.5°C)	1.42	1.7
G4S06508QT	DFN8*8	650	8(152°C)	1.42	1.7
G4S6508Z	DFN5*6	650	8(150.5°C)	1.42	1.7
G4S06510AT	TO-220AC	650	10(151°C)	1.38	1.7
G4S06510CT	TO-252	650	10(156°C)	1.37	1.7
G4S06510DT	TO-263	650	10(158.5°C)	1.37	1.7
G4S06510HT	TO-220F	650	10(130.5°C)	1.37	1.7
G4S06510JT	TO-220ISO	650	10(141.5°C)	1.37	1.7
G4S06510PT	TO-247AC-2L	650	10(155°C)	1.37	1.7
G4S06510QT	DFN8*8	650	10(151°C)	1.37	1.7
G4H06510AT	TO-220AC	650	10(142.5°C)	1.51	1.7
G4H06510HT	TO-220AC	650	10(106°C)	1.5	1.7
G4H06510DT	TO-263	650	10(143°C)	1.51	1.7
G6S06515A	TO-220AC	650	15(157°C)	1.49	1.7
G4S06515AT	TO-220AC	650	15(143°C)	1.5	1.7
G4S06515CT	TO-252	650	15(143°C)	1.5	1.7
G4S06515DT	TO-263	650	15(144°C)	1.5	1.7
G4S06515HT	TO-220F	650	12.5(125°C)	1.5	1.7
G4S06515PT	TO-247AC-2L	650	15(140.5°C)	1.5	1.7
G4S06515QT	DFN8*8	650	15(135°C)	1.5	1.7
G4S06515LT	TO-247AB-3L	650	15(140.5°C)	1.5	1.7
G4S06512BT	TO-247AB-3L	650	6*(139°C)	1.68	1.8
G4S06516BT	TO-247AB-3L	650	8*(154.5°C)	1.42	1.7
G4S06520BT	TO-247AB-3L	650	10*(155°C)	1.37	1.7

Note: If for 7000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流		正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tj=25°C	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max	
G4S06530BT	TO-247AB-3L	650	15*(142°C)	1.5	1.7	
G4S06540PT	TO-247AC-2L	650	40(139°C)	1.47	1.7	
G5S06504AT	TO-220AC	650	4(150°C)	1.4	1.6	
G5S06504CT	TO-252	650	4(154°C)	1.42	1.6	
G5S06504HT	TO-220F	650	4(145°C)	1.4	1.6	
G5S6504Z	DFN5*6	650	4(152°C)	1.42	1.6	
G5S06506AT	TO-220AC	650	6(158°C)	1.32	1.5	
G5S06506DT	TO-263	650	6(157°C)	1.3	1.5	
G5S06506HT	TO-220F	650	6(152°C)	1.3	1.5	
G5S06506QT	DFN8*8	650	6(159.5°C)	1.32	1.5	
G5S6506Z	DFN5*6	650	6(163°C)	1.32	1.5	
G5S06508AT	TO-220AC	650	8(160.5°C)	1.3	1.5	
G5S06508CT	TO-252	650	8(161.5°C)	1.3	1.5	
G5S06508DT	TO-263	650	8(158°C)	1.3	1.5	
G5S06508HT	TO-220F	650	8(145°C)	1.3	1.5	
G5S06508QT	DFN8*8	650	8(158°C)	1.3	1.5	
G5S06510AT	TO-220AC	650	10(156.5°C)	1.33	1.5	
G5S06510DT	TO-263	650	10(157°C)	1.3	1.5	
G5S06510HT	TO-220F	650	10(140°C)	1.3	1.5	
G5S06510PT	TO-247AC-2L	650	10(157°C)	1.33	1.5	
G5S06520BT	TO-247AB-3L	650	10*(158°C)	1.33	1.5	
G5S12001CT	TO-252	1200	1(164.5°C)	1.39	1.7	
G5S12002A	TO-220AC	1200	2(166°C)	1.36	1.7	
G5S12002C	TO-252	1200	2(164°C)	1.36	1.7	
G5S12002H	TO-220F	1200	2(160.5°C)	1.36	1.7	

Note: If for 000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流		正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tj=25°C	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max	
G5S12002R	TO-252左脚悬空	1200	2(165°C)	1.36	1.7	
G5S12005A	TO-220AC	1200	5(161°C)	1.38	1.7	
G5S12005C	TO-252	1200	5(161°C)	1.38	1.7	
G5S12005P	TO-247AC-2L	1200	5(159°C)	1.38	1.7	
G5S12005H	TO-220F	1200	5(153°C)	1.38	1.7	
G5S12008A	TO-220AC	1200	8(153°C)	1.45	1.7	
G5S12008AT	TO-220AC	1200	8(145°C)	1.52	1.7	
G5S12008C	TO-252	1200	8(155°C)	1.45	1.7	
G5S12008D	TO-263	1200	8(152.5°C)	1.45	1.7	
G5S12008H	TO-220F	1200	8(129°C)	1.47	1.7	
G5S12008PM	TO-247AC-2L	1200	8(157.5°C)	1.45	1.7	
G5S12008PMT	TO-247AC-2L	1200	8(151°C)	1.52	1.7	
G5S12010A	TO-220AC	1200	10(156°C)	1.39	1.7	
G5S12010AT	TO-220AC	1200	10(146.5°C)	1.47	1.7	
G5S12010C	TO-252	1200	10(154°C)	1.39	1.7	
G5S12010D	TO-263	1200	10(151°C)	1.39	1.7	
G5S12010DT	TO-263	1200	10(147°C)	1.47	1.7	
G5S12010PMT	TO-247AC-2L	1200	10(149.5°C)	1.47	1.7	
G5S12010M	TO-220F	1200	10(148.5°C)	1.39	1.7	
G5S12015A	TO-220AC	1200	15(155.5°C)	1.4	1.7	
G5S12015AT	TO-220AC	1200	15(143°C)	1.5	1.7	
G5S12015DT	TO-263	1200	15(140.5°C)	1.5	1.7	
G5S12015PM	TO-247AC-2L	1200	15(150.5°C)	1.4	1.7	
G5S12015PMT	TO-247AC-2L	1200	15(141.5°C)	1.5	1.7	
G5S12015M	TO-220F(DG)	1200	15(139°C)	1.4	1.7	

Note: If for 7000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流		正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tc=160°C	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max	
G5S12020A	TO-220AC	1200	20(151°C)	1.45	1.7	
G5S12020AT	TO-220AC	1200	20(148.5°C)	1.47	1.7	
G5S12020D	TO-263	1200	20(148°C)	1.45	1.7	
G5S12020DT	TO-263	1200	20(142°C)	1.47	1.7	
G5S12020HT	TO-220F(SG)	1200	20(101.5°C)	1.47	1.7	
G5S12020U	TO-263	1200	20(148°C)	1.45	1.7	
G5S12030PPM	TO-247AC-2L	1200	30(150.5°C)	1.4	1.7	
G5S12030PPMT	TO-247AC-2L	1200	30(147°C)	1.5	1.7	
G5S12030BH	TO-247AB-3L	1200	15*(150°C)	1.4	1.7	
G5S12040PPM	TO-247AC-2L	1200	40(150°C)	1.45	1.7	
G5S12010BM	TO-247AB-3L	1200	5*(158°C)	1.36	1.7	
G5S12016BM	TO-247AB-3L	1200	8*(153.5°C)	1.45	1.7	
G5S12016BMT	TO-247AB-3L	1200	8*(148°C)	1.52	1.7	
G5S12020BM	TO-247AB-3L	1200	10*(153.5°C)	1.39	1.7	
G5S12020BMT	TO-247AB-3L	1200	10*(149.5°C)	1.47	1.7	
G5S12030BM	TO-247AB-3L	1200	15*(150.5°C)	1.4	1.7	
G5S12030BMT	TO-247AB-3L	1200	15*(147°C)	1.5	1.7	
G5S12040BM	TO-247AB-3L	1200	20*(150°C)	1.45	1.7	
G5S12040BMT	TO-247AB-3L	1200	20*(149°C)	1.47	1.7	
G5S12040PPMT	TO-247AC-2L	1200	40(149°C)	1.47	1.7	
G5S12030PMT	TO-247AC-2L	1200	30(146°C)	1.5	1.7	
G5S12040PMT	TO-247AC-2L	1200	40(144°C)	1.53	1.7	
G5S12010PM	TO-247AC-2L	1200	10(153.5°C)	1.39	1.7	
G5S12020PM	TO-247AC-2L	1200	20(150°C)	1.45	1.7	
G5S12020PMT	TO-247AC-2L	1200	20(149.5°C)	1.47	1.7	

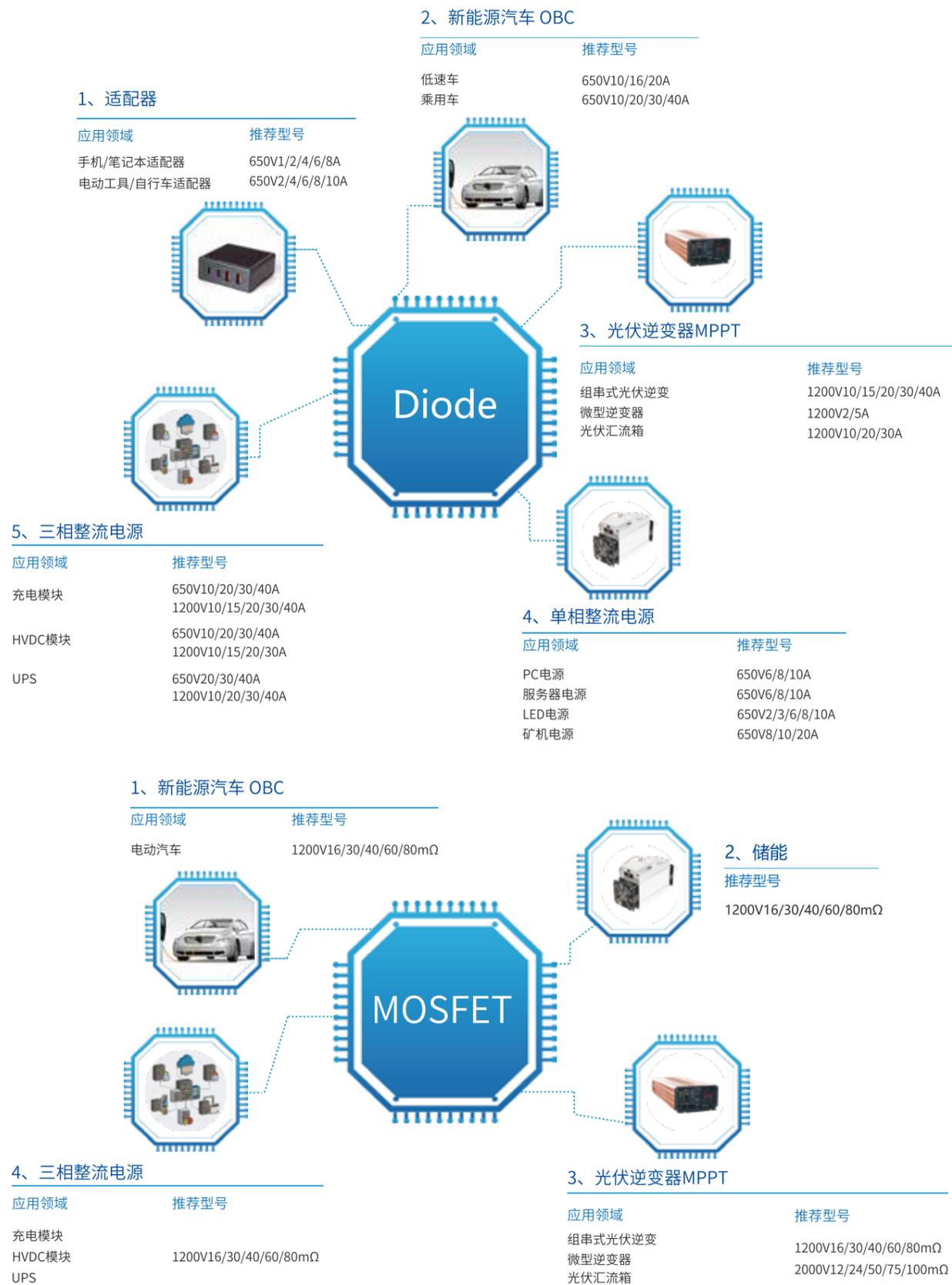
Note: If for 7000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

## 碳化硅二极管选型表

料号	封装	反向重复电压	正向平均电流		正向压降VF (V)	
			IF(A)	Tc=160°C	Tj=25°C	
ID	Package	Vrrm(V)	Tc=160°C	typ	max	
G5S12050PM	TO-247AC-2L	1200	50(139°C)	1.43	1.7	
G5S12050PPMT	TO-247AC-2L	1200	50(152°C)	1.48	1.7	
G5S12060BMT	TO-247AB-3L	1200	30*(146°C)	1.5	1.7	
G5S12060PPMT	TO-247AC-2L	1200	60(147°C)	1.5	1.7	
G5S12080BMT	TO-247AB-3L	1200	40*(144°C)	1.53	1.7	
G5S12050BMT	TO-247AB-3L	1200	25*(152°C)	1.48	1.7	
G5S120100BM	TO-247AB-3L	1200	100(147.5°C)	1.43	1.7	
G70.5YT	SMA	1700	0.5(164.5°C)	1.52	1.7	
G3S17005A	TO-220AC	1700	5(168.5°C)	1.32	1.7	
G3S17005C	TO-252	1700	5(163°C)	1.35	1.7	
G3S17005P	TO-247AC-2L	1700	5(167°C)	1.32	1.7	
G3S17010A	TO-220AC	1700	10(167°C)	1.36	1.7	
G3S17010P	TO-247AC-2L	1700	10(165.5°C)	1.36	1.7	
G3S17050PM	TO-247AC-2L	1700	50(151°C)	1.52	1.9	
G3S17020PPM	TO-247AC-2L	1700	20(165°C)	1.36	1.7	
G3S20010PM	TO-247AC-2L	2000	10(165.5°C)	1.36	1.7	
G3S20020PPM	TO-247AC-2L	2000	20(165°C)	1.36	1.7	
G3S20050PM	TO-247AC-2L	2000	50(151°C)	1.52	1.9	
G1S33001P	TO-247AC-2L	3300	1(170.5°C)	1.81	2	
G1S33005P	TO-247AC-2L	3300	5(160.5°C)	2.1	3	

Note: If for 7000V/9000V (1/5A) sic module please contact:010-82156177

# >>> 功率器件应用领域



# >>> 联系我们

泰科天润半导体科技(北京)有限公司立足于北京和湖南浏阳,建立上海、深圳办事处。美国、欧洲、新加坡、韩国、日本等地都有代理渠道提供服务支持。未来泰科天润将通过资本实力、资产规模、业务开拓、市场占有率等方面的跨越式发展,加速提升综合实力和市场竞争力,向国内各省市区域和国际市场扩张。

## ■ 研发中心/产线 ■ 办事处 ■ 销售市场(海外)

北京(8寸晶圆厂)  
长沙(6寸晶圆厂)

上海办事处  
深圳办事处

美国  
欧洲  
日本  
韩国  
新加坡

### ■ 泰科天润半导体科技(北京)有限公司(总部)

地址:北京市顺义区文良街15号1号楼2层东侧  
邮箱:market@gpt.cn  
电话:010-82156177

### ■ 浏阳泰科天润半导体技术有限公司(厂线)

地址:湖南省浏阳市高新技术产业开发区永和南路金阳新能源产业园18号  
电话:0731-81810988转8015  
邮箱:market@gpt.cn



泰科天润官网



线上商城



微信公众号